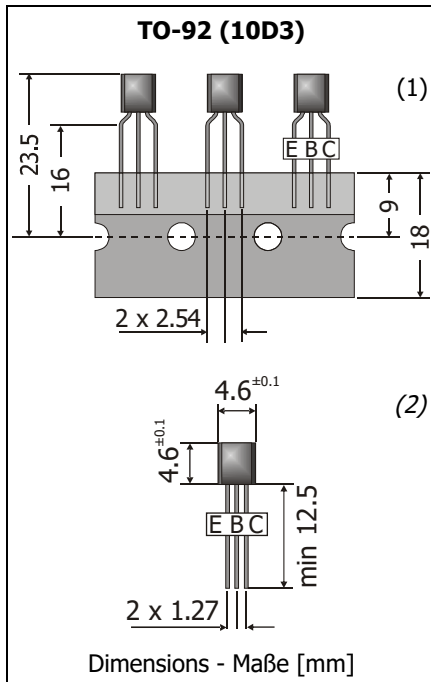


<b>MPSA92</b> <b>High Voltage PNP Transistors</b> <b>Hochspannungs-PNP-Transistoren</b>	$I_C = - 500 \text{ mA}$ $h_{FE1} > 40$ $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$	$V_{CE0} = - 300 \text{ V}$ $P_{tot} = 625 \text{ mW}$
---	--	---

Version 2018-01-19



**Typical Applications**

Signal processing,  
Switching, Amplification  
Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

High collector voltage  
Compliant to RoHS, REACH,  
Conflict Minerals <sup>1)</sup>



**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000
Weight approx.	0.18 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,  
Schalten, Verstärken  
Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Hohe Kollektorspannung  
Konform zu RoHS, REACH,  
Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)	
(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")	
Gewicht ca.	0.18 g
Gehäusematerial	UL 94V-0
Löt- und Einbaubedingungen	260°C/10s MSL N/A

<b>Recommended complementary NPN transistors</b> <b>Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren</b>	MPSA42
--	--------

**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

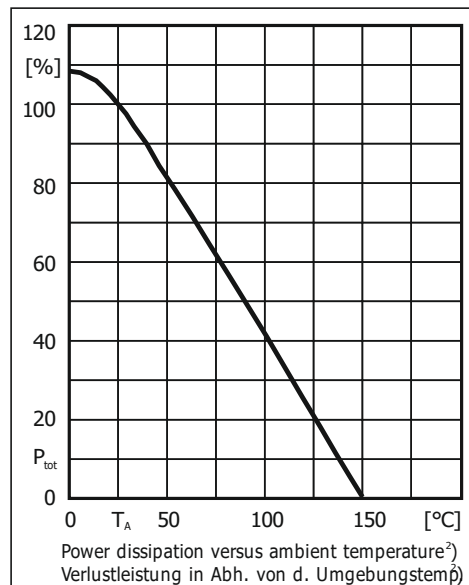
**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

			MPSA92
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V <sub>CE0</sub>	300 V
Collector-Base-voltage Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V <sub>CBO</sub>	300 V
Emitter-Base-voltage Emitter-Basis-Spannung	C open	- V <sub>EBO</sub>	5 V
Power dissipation Verlustleistung		P <sub>tot</sub>	625 mW <sup>3)</sup>
Collector current Kollektorstrom	DC	- I <sub>C</sub>	500 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>j</sub> T <sub>s</sub>	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
2 T<sub>A</sub> = 25°C, unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C, wenn nicht anders angegeben  
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0$ $-V_{CB} = 200\text{ V}$		$-I_{CBO}$	–	–	250 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_B = 0$ $-V_{EB} = 3\text{ V}$		$-I_{EBO}$	–	–	100 nA
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup> $-I_C = 20\text{ mA}$ $-I_B = 2\text{ mA}$		$-V_{CEsat}$	–	–	500 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>4)</sup> $-I_C = 20\text{ mA}$ $-I_B = 2\text{ mA}$		$-V_{BEsat}$	–	–	0.9 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup> $-V_{CE} = 10\text{ V}$ $-I_C = 1\text{ mA}$ $-I_C = 10\text{ mA}$ $-I_C = 30\text{ mA}$		$h_{FE}$	25 40 25	– – –	– – –
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $-V_{CE} = 20\text{ V}$ , $-I_C = 10\text{ mA}$ , $f = 100\text{ MHz}$		$f_T$	–	70 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $-V_{CB} = 20\text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$		$C_{CBO}$	–	–	7 pF
Thermal resistance junction – ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		$R_{thA}$	< 200 K/W <sup>2)</sup>		



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$   
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden